

# 2SA1170

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形トランジスタ

☆2SC2774とコンプリメンタリペアになります。

☆レジンモールドケース

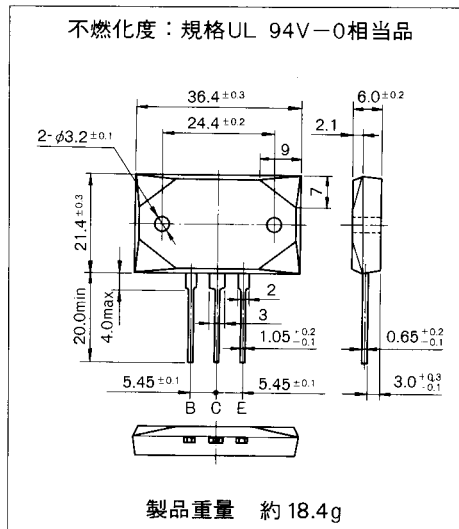
○一般用

## 最大定格 (Ta=25℃)

項目	記号	2SA1170	単位
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	-200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE0</sub>	-200	V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB0</sub>	-6	V
コレクタ電流	I <sub>c</sub>	-17	A
ベース電流	I <sub>B</sub>	-5	A
許容コレクタ損失	P <sub>C</sub>	200 (フランジ温度25℃)	W
接合温度	T <sub>j</sub>	150	℃
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~+150	℃

外形図

単位: mm



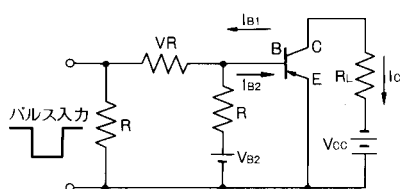
## 電気的特性 (Ta=25℃)

項目	記号	試験条件	2SA1170	単位
最大コレクタ遮断電流	I <sub>cBO</sub>	V <sub>CB</sub> = -200V	-100	μA
最大エミッタ遮断電流	I <sub>eBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -6V	-100	μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V <sub>(BR)CEO</sub>	I <sub>c</sub> = -50mA	-200	V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = -4V I <sub>c</sub> = -8A	20 min	
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = -10A I <sub>B</sub> = -1A	-2.5 max	V
遮断周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -12V I <sub>E</sub> = 1A	20 typ	MHz

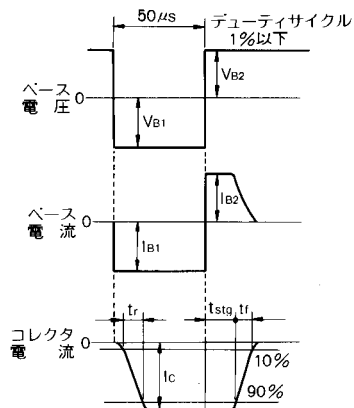
## 代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>c</sub> (A)	V <sub>B2</sub> (V)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>r</sub> (μs)	t <sub>stg</sub> (μs)	t <sub>f</sub> (μs)
-40	4	-10	5	-1000	1000	0.6typ	0.9typ	0.2typ

## スイッチング特性測定回路



## 測定波形



## P<sub>C</sub>-T<sub>a</sub> 定格

